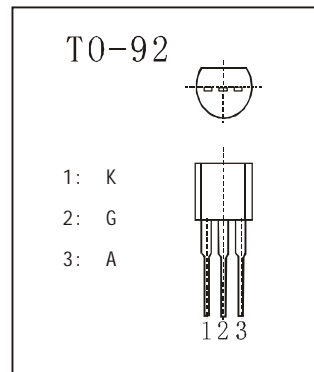


## 单向可控硅—TSE100-8

主要用于漏电保护器、彩灯控制器、逻辑电路驱动、大功率可控硅门极驱动，摩托车点火器及其它开关控制电路。



### 1、特点

- 通态压降低
- 断态重复峰值电压高
- 触发灵敏度高
- 可靠性好
- 封装形式: T0-92

### 2、电极性

极限参数 (Ta=25℃)

参数名称	符号	额定值	单位
断态重复峰值电压	$V_{DRM}$	600	V
反向重复峰值电压	$V_{RRM}$	600	V
通态平均电流	$I_{T(AV)}$	1	A
通态峰值电流	$I_{T(RMS)}$	1.5	A
通态不重复浪涌电流	$I_{TSM}$	10	A
结温	$T_J$	125	℃
贮存温度	$T_{atg}$	-40 ~ 125	℃

电参数 (Ta=25℃)

参数名称	符号	单位	规范值			测试条件
			最小值	典型值	最大值	
断态重复峰值电压	$V_{DRM}$	V	600	650		$I_R=50 \mu A$
反向重复峰值电压	$V_{RRM}$	V	600	650		

断态重复峰值电流	$I_{DRM}$	$\mu A$			20	$V_{DRM}=600V$
通态峰值电压	$V_{TM}$	V		1.3	1.7	$I_T=2A$
维持电流	$I_H$	mA			5	$I_T=0.1A, I_{GT}=0.12mA$
关闭电流	$I_L$	mA		0.17	10	$V_D=12V, I_{CT}=0.1A$
控制极触发电流※	$I_{GT}$	$\mu A$	10	30	100	$V_D=6V, R_L=100\Omega$
控制极触发电压	$V_{GT}$	V	0.4		0.8	$V_D=6V, R_L=100\Omega$
控制极最大电流	$I_{GM}$	A			0.5	
控制极最高电压	$V_{GM}$	V			5	
控制极最高反向电压	$V_{RGM}$	V			5	
电压上升速率	$dV/dt$			25		$V_{DM}=67\%V_{DRM}, T_j=125^\circ C, R_L=1k\Omega$
电流上升速率	$dI_t/dt$	A/ $\mu s$			50	$I_T=2A, I_G=10mA, dI_G=100mA/\mu s$
控制极不触发电压	$V_{GD}$	V	0.1			$V_{DRM}=400V, R_{GR}=1K\Omega, T_j=110^\circ C$

※：该参数与环境温度有关